

(19)日本国特許庁 ( J P )

(12) 公 開 特 許 公 報 ( A )

(11)特許出願公開番号

特開2003 - 197368

(P2003 - 197368A)

(43)公開日 平成15年7月11日(2003.7.11)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-マコード <sup>*</sup> ( 参考 )
H 0 5 B 33/04		H 0 5 B 33/04	3 K 0 0 7
33/10		33/10	
33/14		33/14	A
33/22		33/22	Z
33/26		33/26	Z
審査請求 未請求 請求項の数 37 O L ( 全 12数 ) 最終頁に続く			

(21)出願番号 特願2002 - 217117(P2002 - 217117)

(22)出願日 平成14年7月25日(2002.7.25)

(31)優先権主張番号 2001 - 085101

(32)優先日 平成13年12月26日(2001.12.26)

(33)優先権主張国 韓国(KR)

(71)出願人 590002817

三星エスディアイ株式会社

大韓民国京畿道水原市八達區 しん 洞57  
5番地

(72)発明者 李 準培

大韓民国京畿道龍仁市水枝邑664番地 星志  
アパート505棟1301号

(72)発明者 朴 昌元

大韓民国京畿道水原市靈通洞1047 - 1番地  
清明マウル4団地建栄アパート421棟902号

(74)代理人 100069431

弁理士 和田 成則

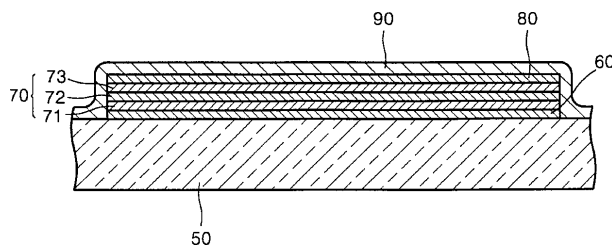
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 有機電界発光表示装置

(57)【要約】

【課題】 外部光の反射率を大幅に減らして具現される画像のコントラストと輝度とを向上させ、特に外部光を遮断するための偏光板を除去して生産性の向上を図れる有機電界発光表示装置を提供する。

【解決手段】 透明な基板50と、基板50の上面に所定パターンで形成されて透明な導電性材質よりなる第1電極部60と、第1電極部60の上面に所定のパターンの有機膜が積層されてなる有機電界発光部70と、第1電極部60と対応するように有機電界発光部70の上面に所定のパターンで形成された第2電極部80と、前記第1電極部、電界発光部、第2電極部を覆って保護するように形成されるとともに、第1成分とFe、Co、V、Ti、Al、Ag、Ptよりなる群から選択された一つ以上の第2成分とを含んでなる封止層90とにより、有機電界発光表示装置が構成されるものとする。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 透明な基板と、

前記基板の上面に所定パターンで形成されて透明な導電性材質よりなる第 1 電極部と、

前記第 1 電極部の上部に所定のパターンの有機膜が積層されてなる有機電界発光部と、

前記第 1 電極部と対応するように前記有機電界発光部の上面に所定のパターンで形成された第 2 電極部と、

前記第 1 電極部、前記有機電界発光部、前記第 2 電極部を覆って保護するように形成されるとともに、第 1 成分と Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Pt よりなる群から選択された一つ以上の第 2 成分とを含んでなる封止層とを備えることを特徴とする有機電界発光表示装置。

【請求項 2】 前記第 1 成分は  $\text{SiO}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{SiN}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{MgF}_2$ 、 $\text{CaF}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SnO}_2$ 、 $\text{In}_2\text{O}_3$  及び ITO よりなる群から選択される一つ以上の誘電性物質であることを特徴とする請求項 1 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 3】 前記封止層は厚さ方向に漸進的な濃度勾配を有することを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 4】 前記漸進的な濃度勾配は、前記封止層の厚さ方向に沿って外部光の入射方向から離れるほど光吸収率が漸進的に増加するようになっていることを特徴とする請求項 1 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 5】 前記漸進的な濃度勾配は、前記封止層の厚さ方向に沿って外部光の入射方向から離れるほど前記誘電性物質の含量は次第に減少し、前記第 2 成分の金属成分の含量は次第に増加するように分布されていることを特徴とする請求項 4 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 6】 前記第 2 電極部は Ca が蒸着されてなる第 1 電極層と、前記第 1 電極層の上面に形成された導電性透明電極層とよりなることを特徴とする請求項 1 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 7】 前記第 2 電極部の面抵抗が  $1 \text{ } \Omega/\square$  以下であることを特徴とする請求項 6 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 8】 前記第 2 電極部が ITO よりなることを特徴とする請求項 1 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 9】 前記封止層の内部に、第 1 電極部、有機電界発光部及び第 2 電極部を覆う保護膜がさらに備わっていることを特徴とする請求項 1 または請求項 8 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 10】 透明な基板と、

前記基板の上面に所定パターンで形成されて透明な導電性材質よりなる第 1 電極部と、

前記第 1 電極部の上部に所定パターンの有機膜が積層されてなる有機電界発光部と、

前記有機電界発光部の上面に形成されるとともに、第 1 成分と Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Pt よりな

る群から選択された一つ以上の第 2 成分とよりなる第 2 電極部と、

前記第 1 電極部、前記有機電界発光部、前記第 2 電極部を覆う封止層とを備えてなることを特徴とする有機電界発光表示装置。

【請求項 11】 前記第 2 電極部の第 1 成分と第 2 成分とが厚さ方向に漸進的な濃度勾配を有することを特徴とする請求項 10 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 12】 前記漸進的な濃度勾配は前記第 2 電極部の厚さ方向に沿って外部光の入射方向から離れるほど光吸収率が次第に増加するようになっていることを特徴とする請求項 11 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 13】 前記漸進的な濃度勾配は、前記第 2 電極部の厚さ方向に沿って外部光の入射方向から離れるほど前記誘電性物質の含量は次第に増加し、前記金属成分の含量は次第に減少するように分布されていることを特徴とする請求項 11 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 14】 前記封止層はアルミニウムまたはこの合金よりなり、前記封止層と第 1 電極部とを絶縁させる絶縁層を具備してなることを特徴とする請求項 10 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 15】 透明な基板と、

前記基板の上面に形成されて外部光を吸収する外光吸収膜と、

前記外光吸収膜の上面に形成された第 2 電極部と、

前記第 2 電極部の上面に所定パターンの有機膜が積層されてなる有機電界発光部と、

前記有機電界発光部の上面に所定パターンで形成された第 1 電極部とを含んでなることを特徴とする有機電界発光表示装置。

【請求項 16】 前記外光吸収膜は、 $\text{SiO}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{SiN}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{MgF}_2$ 、 $\text{CaF}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SnO}_2$ 、 $\text{In}_2\text{O}_3$  及び ITO よりなる群から選択される一つ以上の誘電性物質よりなる第 1 成分と、Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Pt よりなる群から選択された一つ以上の第 2 成分とよりなることを特徴とする請求項 15 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 17】 前記外光吸収膜は漸進的な濃度勾配を有するように構成されていることを特徴とする請求項 15 及び請求項 16 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 18】 前記外光吸収膜の第 1 成分と第 2 成分とが封止層の厚さによって漸進的な濃度勾配を有するようになっていることを特徴とする請求項 16 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 19】 前記外光吸収膜は、外部光の入射方向から離れるほど前記第 1 成分の誘電性物質の含量は次第に増加し、前記第 2 成分の金属成分の含量は次第に減少するように分布されていることを特徴とする請求項 16 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 20】 透明な基板と、前記基板上に所定のパターンで形成されたアノード層と、前記アノード層の上面に有機膜が積層されてなる有機電界発光部と、前記有機電界発光部が露出されるように前記基板の上面に形成された絶縁性保護膜と、前記有機電界発光部と前記絶縁性保護膜の上面に所定のパターンで形成されたカソード層を含む画素領域と、前記透明な基板上に形成されて前記アノード層に選択的に電位を印加するための薄膜トランジスタを含む駆動領域と、前記基板の上面に前記アノード層と絶縁される外光吸収膜が形成されたことを特徴とする有機電界発光表示装置。

【請求項 21】 前記外光吸収膜は、 $\text{SiO}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{SiN}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{MgF}_2$ 、 $\text{CaF}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SnO}_2$ 、 $\text{In}_2\text{O}_3$  及び ITO よりなる群から選択される一つ以上の誘電性物質よりなる第 1 成分と、Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Pt よりなる群から選択された一つ以上の第 2 成分とよりなることを特徴とする請求項 20 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 22】 前記外光吸収膜は漸進的な濃度勾配を有するように構成されることを特徴とする請求項 21 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 23】 前記外光吸収膜の上面に形成されたバッファ層をさらに具備してなることを特徴とする請求項 20 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 24】 前記アノード層とカソード層とが透明電極であることを特徴とする請求項 20 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 25】 前記外光吸収膜は前記基板の全面に形成されたことを特徴とする請求項 20 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 26】 前記外光吸収膜は前記画素領域を除外した前記基板の全面にわたって形成されたことを特徴とする請求項 20 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 27】 透明な基板と、前記基板上に所定のパターンで形成されたアノード層と、前記アノード層の上面に有機膜が積層されてなる有機電界発光部と、前記有機電界発光部が露出されるように前記基板の上面に形成された絶縁性保護膜と、前記有機電界発光部と前記絶縁性保護膜の上面に所定のパターンで形成されたカソード層を含む画素領域と、前記透明な基板上に形成されて前記アノード層に選択的に電圧を印加するための薄膜トランジスタを含む駆動領域とを含み、前記アノード層が外光吸収膜よりなることを特徴とする有機電界発光表示装置。

【請求項 28】 前記アノード層をなす外光吸収膜は、 $\text{SiO}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{SiN}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{MgF}_2$ 、 $\text{CaF}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SnO}_2$ 、 $\text{In}_2\text{O}_3$  及び ITO

O よりなる群から選択される一つ以上の誘電性物質よりなる第 1 成分と、Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Pt よりなる群から選択された一つ以上の第 2 成分とよりなることを特徴とする請求項 27 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 29】 透明な基板と、前記基板に形成されたバッファ層と、前記バッファ層に形成された薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを埋め込む中間絶縁体層と、前記中間絶縁体層の上面に所定のパターンで形成されて前記薄膜トランジスタにより選択的に電位が印加される透明電極層と、前記透明電極層が露出されるように開口部が形成された絶縁性保護膜と、前記透明電極層の上面に有機膜が積層されてなる有機電界発光部と、前記有機電界発光部と前記絶縁性保護膜の上面に所定のパターンで形成されたカソード層とを含み、前記有機電界発光部と対応する領域を除外した中間絶縁体層と絶縁性保護膜との間に外光吸収膜が形成されたことを特徴とする有機電界発光表示装置。

【請求項 30】 前記外光吸収膜は、 $\text{SiO}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{SiN}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{MgF}_2$ 、 $\text{CaF}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SnO}_2$ 、 $\text{In}_2\text{O}_3$  及び ITO よりなる群から選択される一つ以上の誘電性物質よりなる第 1 成分と、Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Pt よりなる群から選択された一つ以上の第 2 成分とよりなることを特徴とする請求項 29 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 31】 透明な基板と、前記基板に形成されたバッファ層と、前記バッファ層に形成された薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを埋め込む中間絶縁体層と、前記中間絶縁体層の上面に所定のパターンで形成されて前記薄膜トランジスタにより選択的に電位が印加される透明電極層と、前記透明電極層が露出されるように開口部が形成された絶縁性保護膜と、前記透明電極層の上面に有機膜が積層されてなる有機電界発光部と、前記有機電界発光部と前記絶縁性保護膜の上面に所定のパターンで形成された透明なカソード層とを含み、前記カソード層が誘電性物質である第 1 成分と、Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Pt よりなる群から選択された一つ以上の第 2 成分とを含んでなることを特徴とする有機電界発光表示装置。

【請求項 32】 前記カソード層の第 1 成分は、 $\text{SiO}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{SiN}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{MgF}_2$ 、 $\text{CaF}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SnO}_2$ 、 $\text{In}_2\text{O}_3$  及び ITO よりなる群から選択される一つ以上の誘電性物質であることを特徴とする請求項 31 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 33】 前記第 1 成分と第 2 成分とがカソード層の厚さ方向に漸進的な濃度勾配を有することを特徴とする請求項 31 または請求項 32 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 3 4】 透明な基板を備える第 1 段階と、  
前記基板に所定パターンの第 1 電極部を形成する第 2 段階と、  
前記第 1 電極部の上面に多数の有機膜が積層されてなる有機電界発光部を形成する第 3 段階と、  
前記有機電界発光部の上面に第 1 電極部と共に前記有機電界発光部を駆動させるための第 2 電極部を形成する第 4 段階と、  
誘電性物質の第 1 成分と金属物質の第 2 成分とが濃度勾配を有し、かつ前記第 1 電極部、前記有機電界発光部及び前記第 2 電極部を覆う封止層を形成する第 5 段階とを含むことを特徴とする有機電界発光表示装置の製造方法。

【請求項 3 5】 前記 5 段階において、  
相異なる融点特性を有する誘電性物質の SiO を 3 ないし 50 重量 % 含みかつ Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Cu、Pt よりなる群から選択された一つ以上の金属を 50 ないし 97 重量 % 含んでなる誘電性物質と金属の混合物を、一つの蒸着ポートに投入する段階と、前記封止層を形成するため前記蒸着ポートの温度を順次増加させつつ SiO と金属とを蒸着する段階とを含むことを特徴とする請求項 3 4 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

【請求項 3 6】 透明な基板と、  
前記基板の上面に所定パターンで形成され透明な導電性材質よりなる第 1 電極部と、  
前記第 1 電極部の上部に所定パターンの有機膜が積層されてなる有機電界発光部と、  
前記第 1 電極部と対応するように前記有機電界発光部の上面に所定のパターンで形成された第 2 電極部と、  
前記第 1 電極部、前記有機電界発光部、前記第 2 電極部を覆って保護するように形成されるとともに、その厚さ方向に濃度勾配の構成を有する封止層とを含むことを特徴とする有機電界発光表示装置。

【請求項 3 7】 透明な基板と、  
前記基板に形成されたバッファ層と、  
前記バッファ層に形成された薄膜トランジスタと、  
前記薄膜トランジスタを埋め込む中間絶縁体層と、  
前記中間絶縁体層の上面に所定のパターンで形成されて前記薄膜トランジスタにより選択的に電位が印加される透明電極層と、  
前記透明電極層が露出されるように開口部が形成された絶縁性保護膜と、  
前記透明電極層の上面に有機膜が積層されてなる有機電界発光部と、  
前記有機電界発光部と前記絶縁性保護膜の上面に所定のパターンで形成された透明なカソード層を含み、  
前記カソード層はその厚さ方向に濃度勾配の構成を有することを特徴とする有機電界発光表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は有機電界発光表示装置に係り、より詳細には電極構造及び封止層、外部光反射防止構造が改善された有機電界発光表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】電界発光表示装置は能動発光型表示素子であって、視野角が広くてコントラストが優秀なだけでなく応答速度が速いという長所があつて次世代表示素子として注目されている。このような電界発光表示装置は発光層を形成する物質によって無機電界発光表示装置と有機電界発光装置とに区分される。

【0003】前記無機電界発光表示装置はもともと緑色発光ディスプレイとして商品化されたが、プラズマ表示装置と同じく交流バイアス駆動であり、駆動に数百 V が必要である。また発光のための材料が無機物であるため分子設計による発光波長の制御が難しくて画像のカラー化し難い。

【0004】そして、前記有機電界発光表示装置は、蛍光性有機化合物を電氣的に励起して発光させる自発光型ディスプレイであって、低電圧で駆動が可能で、薄型化が容易であり、光視野角、速い応答速度など液晶表示装置の問題点を解決できる次世代ディスプレイとして注目されている。このような有機電界発光表示装置はイーストマンコダック社により積層型として開発され、パイオニア社により寿命が改善された緑色のディスプレイとして商品化された。一方、有機電界発光表示装置（以下、有機 EL 素子と略称する）においては、有機材料の長所である分子構造が多様な新規材料が開発されて直流低電圧駆動、薄型、自発光性などに優れる特性を有するカラーディスプレイに関する研究が活発に進んでいる。

【0005】このような有機 EL 素子の一例が日本国特開平 10-335060 号に開示されており、これを図 15 に示した。

【0006】図面を参照すれば、有機 EL 素子 10 は、発光領域を含む有機積層構造 11 が陽極 12 と陰極 13 との間に取り付けられるとともに、前記陰極がアルミニウムと、アルミニウムより大きい仕事関数を有する少なくとも一種の材料を含有した封止層 14 とにより保護される構成を有する。

【0007】前記のように構成された従来の有機 EL 素子は陰極 13 と封止層 14 とにより外部光が反射されるので画像の読取り能 (readability) が劣るという問題点を有している。特に太陽光に露出された室外では前記陰極 13 による外部光反射により相対的に輝度とコントラストが急激に低下する。

【0008】米国特許 US 5,059,861 号にはカソードがアルカリ金属以外の多種金属で構成された有機 EL 素子の構成が開示されている。

【0009】米国特許 US 5,047,687 号にはカ

ソードがアルカリ金属でない仕事関数が低い金属を少なくとも一つ以上含む多種の金属で構成された有機 E L 素子が開示されている。ここで前記金属はアルミニウム、バナジウム、コバルト等を含む。

【0010】日本国特開平 9-274990 号には陽極、有機膜層構造、陰極を覆う封止層がシリカゲル、ゼオライト、塩化カルシウム、活性炭、ナイロン及びポリビニルアルコールよりなる群から選択された少なくとも 1 種以上の吸湿剤が含まれた構成が開示されている。

【0011】米国特許 US 5,073,446 号、日本 10 国特開平 5-36475 号、特開平 8-222368 号、および特開平 7-161474 号には陽極、有機膜積層構造、陰極及び陰極保護のための封止層及び密封層の構造が開示されている。

【0012】一方、従来の有機電界発光表示装置の大部分は電極及び有機膜積層構造により輝度が低下することを防止するために、基板の表面に偏光板を使用して外部光反射による画像の輝度低下を減らしている。しかし、前記のように偏光板を使用すれば、有機膜積層構造から発生する光の一部が遮光されるので実質的な輝度減少を 20 誘発する。

【0013】

【発明が解決しようとする課題】本発明の技術的課題は、入射される外部光の反射を減らして画像のコントラスト及び輝度を向上させ、外部光反射を減らすための偏光板を除去できる有機電界発光表示装置を提供することにある。

【0014】

【課題を解決するための手段】前記技術的課題を達成するための本発明の有機電界発光表示装置は、透明な基板 30 と、前記基板の上面に所定パターンで形成されて透明な導電性材質よりなる第 1 電極部と、前記第 1 電極部の上面に所定のパターンの有機膜が積層されてなる有機電界発光部と、前記第 1 電極部と対応するように前記有機電界発光部の上面に所定のパターンで形成された第 2 電極部と、前記第 1 電極部、前記有機電界発光部、前記第 2 電極部を覆って保護するように形成されるとともに、第 1 成分と Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Pt よりなる群から選択された一つ以上の第 2 成分とを含んでなる封止層とを備えることを特徴とする。

【0015】本発明において、前記第 1 成分は  $\text{SiO}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{SiN}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{MgF}_2$ 、 $\text{CaF}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SnO}_2$ 、 $\text{In}_2\text{O}_3$  及び ITO (Indium Tin Oxide) よりなる群から選択される一つ以上の誘電性物質であり、前記第 1 成分と第 2 成分が封止層の厚さによって漸進的な濃度勾配を有する。前記漸進的な濃度勾配は前記封止層の厚さ方向に沿って外部光の入射方向から離れるほど光吸収率が漸進的に増加する。

【0016】前記技術的課題を達成するための本発明の 50

有機電界発光表示装置の他の特徴は、透明な基板と、前記基板の上面に所定パターンで形成されて透明な導電性材質よりなる第 1 電極部と、前記第 1 電極部の上面に所定パターンの有機膜が積層されてなる有機電界発光部と、前記電界発光部の上面に形成されるとともに、第 1 成分と Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Pt よりなる群から選択された一つ以上の第 2 成分とよりなる第 2 電極部と、前記第 1 電極部、前記有機電界発光部、前記第 2 電極部を覆う封止層とを含んでなることを特徴とする。

【0017】また、前記技術的課題を達成するための本発明の有機電界発光表示装置のさらに他の特徴は、透明な基板と、前記透明な基板の上面に形成されて外部光を吸収する外光吸収膜と、前記外光吸収膜の上面に形成された第 2 電極部と、前記第 2 電極部の上面に所定パターンの有機膜が積層されてなる有機電界発光部と、前記有機電界発光部の上面に所定パターンで形成された第 1 電極部とを含んでなることを特徴とする。

【0018】本発明において、前記外光吸収膜は  $\text{SiO}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{SiN}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{MgF}_2$ 、 $\text{CaF}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SnO}_2$ 、 $\text{In}_2\text{O}_3$  及び ITO よりなる群から選択される一つ以上の誘電性物質よりなる第 1 成分と、Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Pt よりなる群から選択された一つ以上の第 2 成分とよりなり、前記外光吸収膜は漸進的な濃度勾配を有するように構成される。

【0019】前記技術的課題を達成するための本発明の有機電界発光表示装置は、透明な基板と、前記基板に形成されたバッファ層と、前記バッファ層に形成された薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを埋め込む中間絶縁体層と、前記中間絶縁体層の上面に所定のパターンで形成されて前記薄膜トランジスタにより選択的に電位が印加される透明電極層と、前記透明電極層が露出されるように開口部が形成された絶縁性保護膜と、前記透明電極層の上面に有機膜が積層されてなる有機電界発光部と、前記有機電界発光部と前記絶縁性保護膜の上面に所定のパターンで形成されたカソード層とを含み、前記有機電界発光部と対応する領域を除外した中間絶縁体層と絶縁性保護膜との間に外光吸収膜が形成されたことを 40 特徴とする。

【0020】前記技術的課題を達成するための本発明のさらに他の有機電界発光表示装置は、透明な基板と、前記基板に形成されたバッファ層と、前記バッファ層に形成された薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを埋め込む中間絶縁体層と、前記中間絶縁体層の上面に所定のパターンで形成されて前記薄膜トランジスタにより選択的に電位が印加される透明電極層と、前記透明電極層が露出されるように開口部が形成された絶縁性保護膜と、前記透明電極層の上面に有機膜が積層されてなる有機電界発光部と、前記有機電界発光部と前記絶縁性保護

膜の上面に所定のパターンで形成された透明なカソード層とを含み、前記カソード層が誘電性物質である第 1 成分と、Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Pt よりなる群から選択された一つ以上の第 2 成分とを含んでなることを特徴とする。

【0021】前記技術的課題を達成するための本発明の有機電界発光表示装置の製造方法は、透明な基板を備える第 1 段階と、前記基板に所定パターンの第 1 電極部を形成する第 2 段階と、前記第 1 電極部の上面に多数の有機膜が積層されてなる有機電界発光部を形成する第 3 段階と、前記有機電界発光部の上面に第 1 電極部と共に前記有機電界発光部を駆動させるための第 2 電極部を形成する第 4 段階と、誘電性物質の第 1 成分と金属物質の第 2 成分とが濃度勾配を有し、かつ前記第 1 電極部、前記有機電界発光部及び前記第 2 電極部を覆う封止層を形成する第 5 段階とを含んでなることを特徴とする。

【0022】本発明において、前記第 5 段階は、相異なる融点特性を有する誘電性物質の  $\text{SiO}$  を 3 ないし 50 重量% 含みかつ Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Cu、Pt よりなる群から選択された一つ以上の金属を 50 ないし 97 重量% 含んでなる誘電性物質と金属の混合物を、一つの蒸着ボートに投入する段階と、前記封止層を形成するため前記蒸着ボートの温度を順次増加させつつ  $\text{SiO}$  と金属とを蒸着する段階とを含む。

【0023】

【発明の実施の形態】以下、添付した図面を参照して本発明の望ましい実施形態について詳細に説明する。

【0024】本発明による有機電界発光表示装置は、封止層または電極が外部光を吸収可能にして画像の輝度を高めるものであって、その一実施形態を図 1 に示した。

【0025】図面を参照すれば、本発明による有機電界発光表示装置は、透明な基板 50 の上面に所定のパターンで形成された透明な第 1 電極部 60 と、前記第 1 電極部 60 の上面に有機膜が積層されてなる有機電界発光部 70 と、前記有機電界発光部 70 の上面に所定のパターンで形成される第 2 電極部 80 と、前記第 1 電極部 60、前記有機電界発光部 70、前記第 2 電極部 80 を覆うように前記基板 50 に形成された、誘電性物質の第 1 成分と少なくとも一つ以上の金属よりなる第 2 成分とを含む封止層 90 とを具備する。

【0026】前記第 1 電極部 60 は透明な基板 50 の上面に形成される陽極であって、透明な導電性材質の ITO よりなり、図面には明確に図示されていないが、相互平行に取り付けられるストライプ状の電極よりなりうる。

【0027】前記有機電界発光部 70 は前記第 1 電極部 60 の上面から順次に積層されるホール輸送層 71、発光層 72、電子輸送層 73 を含む。前記有機電界発光部 70 は有機化合物よりなる有機薄膜であって、特に前記発光層 72 の材料としてはトリス(8-ヒドロキシキノ

リン)アルミニウム( $\text{Alq}_3$ )のような低分子またはポリ(p-フェニレンビニレン)、ポリ(2-メトキシ-5-(2-エチルヘキシルオキシ)-1,4-フェニレンビニレン)などの高分子を使用する。

【0028】前記第 2 電極部 80 は導電性金属よりなり、前記第 1 電極部 60 と直交する方向に形成される多数のストライプ状の電極よりなりうる。

【0029】前記封止層 90 は透明な基板 50 の上面に形成されて第 1 電極部 60、有機電界発光部 70 及び第 2 電極部 80 を覆うが、外部から入射される光を吸収できるように構成される。

【0030】これをより詳細に説明すれば、前記封止層 90 は誘電性物質の前記第 1 成分と、Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Pt よりなる群から選択された一つ以上の第 2 成分とを含んでなり、図 2 に示されたように厚さによって順次に成分濃度勾配を有する。封止層 90 をなす第 1 成分は  $\text{SiO}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{SiN}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{MgF}_2$ 、 $\text{CaF}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SnO}_2$ 、 $\text{In}_2\text{O}_3$  及び ITO よりなる群から選択される一つ以上の誘電性物質よりなる。

【0031】前記封止層 90 の厚さ方向への漸進的な濃度勾配は、図 3 及び図 4 に示されたように前記封止層 90 の厚さ方向に沿って外部光の入射方向から離れるほど光吸収率が漸進的に増加または減少する。また前記濃度勾配を有する封止層 90 は、外部光の入射方向から離れるほど前記誘電性物質の含量は順次に減少し、前記金属成分の含量は順次に増加するように分布される。

【0032】一方、前記第 2 電極部 80 は図 5 に示されたように Ca よりなる第 1 電極層 81 と、この第 1 電極層 81 の上面に導電性透明物質の ITO よりなる第 2 電極層 82 が積層されて面抵抗を  $1/\Omega$  以下にすることが望ましい。そして、前記第 2 電極部 80 が ITO よりなりうるが、この場合、外部光の入射方向から離れるほど前記 ITO 物質の含量は順次に減少し、前記金属成分の含量は順次に増加する分布にすることが望ましい。また前記封止層 90 の内部には水分の遮断のために第 1 電極部 60、有機電界発光部 70 及び第 2 電極部 80 を覆う保護膜 100 がさらに備わりうる。

【0033】図 6 には本発明による有機電界発光表示装置の他の実施形態を示した。この実施形態において図 5 に示された実施形態の場合と同じ符号は同じ構成要素を示す。

【0034】図面を参照すれば、本発明による有機電界発光表示装置は、透明な基板 50、導電性材質よりなる所定パターンの第 1 電極部 60、前記複数の有機膜よりなる有機電界発光部 70 が順次に積層される。そして前記有機電界発光部 70 の上部には第 2 電極部 110 が形成されるが、前記第 2 電極部 110 は誘電性物質の前記第 1 成分と、Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Pt よりなる群から選択された一つ以上の第 2 成分とよりな

る。前記第 2 電極部 110 はその厚さ方向に漸進的な成分濃度勾配を有するが、この漸進的な濃度勾配は前記第 2 電極部 110 の厚さ方向に外部光の入射方向から離れるほど光吸収率が漸進的に増加するようになっており、図 7 に示されたように外部光の入射方向から離れるほど前記誘電性物質の第 1 成分含量は順次に増加し、前記金属成分の第 2 成分含量は順次に減少するように分布される。

【0035】そして第 1 電極部 60、有機電界発光部 70、第 2 電極部 110 は封止層 120 により覆われるが、この封止層 120 はアルミニウムまたはこの合金よりなり、前記封止層 120 と第 1 電極部 60 は絶縁層 21 により絶縁される。

【0036】図 8 には本発明による有機電界発光表示装置の他の実施形態を示した。

【0037】図面を参照すれば、本発明による有機電界発光表示装置は、透明な基板 131 の上面に形成されて外部光を吸収する外光吸収膜 132 と、前記外光吸収膜 132 の上面に形成された第 2 電極部 133 と、前記第 2 電極部 133 の上面に所定パターンの有機膜が積層されてなる有機電界発光部 134 と、前記有機電界発光部 134 の上面に所定のパターンで形成された透明な第 1 電極部 135 とを含む。

【0038】前記外光吸収膜 132 は  $\text{SiO}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{SiN}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{MgF}_2$ 、 $\text{CaF}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SnO}_2$ 、 $\text{In}_2\text{O}_3$  及び ITO よりなる群から選択される一つ以上の誘電性物質よりなる第 1 成分と、Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Pt よりなる群から選択された一つ以上の第 2 成分とよりなり、漸進的な濃度勾配を有し、外部光の入射方向から離れるほど前記第 1 成分の誘電性物質の含量は順次に減少し、前記第 2 成分の金属成分の含量は順次に増加する分布を有する。

【0039】図 9 及び図 10 には AM タイプの有機電界発光表示装置 (Active matrix organic light emitting display; AMOLED) の一例を示した。

【0040】図示されたように透明な基板 200 にはバッファ層 201 が形成され、このバッファ層 201 の上部には各々画素とその画素の形成のための透明電極 210 を有する画素領域 300 と、薄膜トランジスタ (TFT) とキャパシタ 250 とが形成された駆動領域 400 とが設けられる。

【0041】前記駆動領域 400 はバッファ層 201 の上面に所定のパターンで配列された p 型または n 型の半導体層 202 がゲート絶縁層 203 により埋込められ、前記ゲート絶縁層 203 の上面には前記半導体層 202 と対応するゲート電極層 204 と、これを埋込む中間絶縁膜 205 と、前記中間絶縁膜 205 とゲート絶縁層 203 とに形成されたコンタクトホール 206a、207

a を通じて前記半導体層 202 の両側に各々連結され、かつ中間絶縁膜 205 の上部に形成されたドレーン電極 206、ソース電極 207 よりなる薄膜トランジスタと、前記ソース電極 207 と連結されて前記中間絶縁膜 205 の上面に形成された第 1 電極 251 と、この第 1 電極 251 と対向して中間絶縁層 205 に埋込められる第 2 電極 252 とよりなるキャパシタ 250 とが設けられる。

【0042】そして、前記中間絶縁膜 205 の保護膜 208 と、画素形成領域 300 に開口部 209a が形成された平坦化膜 209 とが形成される。前記平坦化膜 209 の開口部 209a の底面には前記ドレーン電極 206 と電気的に連結された透明電極 210 が形成され、この透明電極 210 の上部には有機膜 220 が積層され、前記有機膜 220 と平坦化膜 209 との上部にはカソード層 230 が形成される。

【0043】一方、前記駆動領域 400 をなす薄膜トランジスタとキャパシタ 250 との下部、すなわち第 2 領域と対応する基板 200 とバッファ層 201 との間には外光吸収膜 240 が形成される。この外光吸収膜 240 は前述した実施形態のように  $\text{SiO}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{SiN}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{MgF}_2$ 、 $\text{CaF}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SnO}_2$ 、 $\text{In}_2\text{O}_3$  及び ITO よりなる群から選択される一つ以上の誘電性物質よりなる第 1 成分と、Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Pt よりなる群から選択された一つ以上の第 2 成分とよりなり漸進的な濃度勾配を有する。前記外光吸収膜 240 は外部光の入射方向から離れるほど前記第 1 成分の誘電性物質の含量は順次に減少し、前記第 2 成分の金属成分の含量は順次に増加する分布にすることが望ましい。

【0044】外光吸収膜 240 は図 10 に示されたように画素形成領域の画素領域 300 を除外した領域に形成できる。外光吸収膜 240 は図 11 に示されたように全面発光型で画素領域 300 と対応する保護膜 208 と平坦化膜 209 との間に形成できる。また外光吸収膜 240 は図 12 に示されたように全面発光型の有機電界発光表示装置の場合には基板 200 とバッファ膜 201 との間の全面に形成できる。

【0045】全面発光型誘電電界発光表示装置の他の実施形態を図 13 に示した。

【0046】図面を参照すれば、画素を構成する部分のアノード層の透明電極 210 が前記の第 1 成分のうち ITO 成分と第 2 成分とよりなる。この時に前記透明電極 210 は基板側で第 2 成分の濃度が高くて有機発光層側で第 1 成分の濃度が高い構造を有する。

【0047】本発明の他の実施形態としては、図 14 に示されたように有機電界発光表示装置が背面発光型である場合には前記カソード層 230 は前記第 1 成分と第 2 成分とよりなり、濃度勾配を有するように形成することが望ましい。



【0048】図1を再び参照すれば、前述したように構成された有機電界発光表示装置は第1電極部60及び第2電極部80に所定の電圧が印加されれば、陽極の第1電極部60から注入されたホールがホール輸送層71を経由して発光層72に移動し、電子は第2電極部80から電子輸送層73を経由して発光層72に注入される。この発光層72で電子とホールとが再結合して励起子を生成し、この励起子が励起状態から基底状態に変化するにつれて、発光層72の蛍光性分子が発光して画像が形成される。

【0049】前述したように駆動される有機電界発光表示装置は、前記封止層90または第2電極部80が誘電性物質と金属とが混合された物質よりなって入射される外部光を吸収できるようになっているので、入射された外部光の反射を減らして有機電界発光部70により形成される画像の輝度及びコントラストが低下することを防止できる。

【0050】このような作用効果は前記有機電界発光表示装置の実施例と比較例の輝度の実験を通じてより明らかになる。

【0051】＜実施例1＞透明な基板の上面にITOよりなる第1電極部を形成し、この第1電極部の上面にホール注入層としてフタロシアニン(CuPc: copper phthalocyanine)を400で200の厚さに蒸着させ、その上部にホール輸送層の役割をするN、N-ジ(ナフタレン-1-イル)-N、N-ジフェニル-ベンジジン(NPB)を300で500の厚さに蒸着させた。そして、ホール輸送層の上部にはトリス-8-ヒドロキシキノリンアルミニウム(Alq<sub>3</sub>)とフッ化リチウム(LiF)及びCaを各々400、10、2000の厚さに蒸着し、この上部に第1成分のSiOと第2成分のTiとを濃度勾配を有するように1000の厚さに封止層を形成した。

【0052】前述したように製造された有機電界発光表示装置によると、下記表1に示したように反射率が10%未満で光強度が50cd/m<sup>2</sup>である場合にも具現される画像のコントラストが100:1の優秀な光学特性が確保できた。

【0053】＜実施例2＞Ca電極上に導電性透明物質のITOを蒸着し、前記第2電極部の面抵抗を1 / 40

以下にしたことを除いては実施例1と同じ方法によって実施してパターンニングされたブラックマトリックスを製造した。

【0054】前述したように製造された有機電界発光表示装置によると、下記表1に示したように反射率を10%未満に減らすことができた。

【0055】＜実施例3＞前記第2電極部をITOを利用して製造し、封止層としてITO-メタル系のTiを利用したことを除いては実施例1と同じ方法によって実施してパターンニングされたブラックマトリックスを製造

した。

【0056】前述したように製造された有機電界発光表示装置によると、下記表1に示したように反射率を20%未満に減らすことができた。

【0057】＜実施例4＞前記第2電極部をITOを蒸着して製造して、封止層の内面に第1電極部及び有機電界維持発光部及び第2電極部を覆って水分を遮断する保護膜を形成したことを除いては実施例1と同じ方法によって実施してパターンニングされたブラックマトリックスを製造した。

【0058】前述したように製造された有機電界発光表示装置によると、下記表1に示したように反射率を10%未満に減らすことができ、輝度を後述する比較例の有機電界発光表示装置に比べて50%以上向上させることができた。

【0059】＜実施例5＞透明な基板の上面に誘電性物質の第1成分のSiOと金属成分の第2成分のTiとを濃度勾配を有するように1000の厚さで光吸収層を形成し、この上部にITOよりなる第1電極部を形成し、この第1電極部の上面にホール注入層としてフタロシアニン(CuPc: copper phthalocyanine)を400で200の厚さに蒸着させ、その上部にホール輸送層の役割をするN、N-ジ(ナフタレン-1-イル)-N、N-ジフェニル-ベンジジン(NPB)を300で500の厚さに蒸着させた。そして、ホール輸送層の上部にはトリス-8-ヒドロキシキノリンアルミニウム(Alq<sub>3</sub>)とLiF及びCaを各々400、10、2000の厚さに蒸着させた。

【0060】前述したように製造された有機電界発光表示装置によると、下記表1に示したように反射率を10%未満に減らすことができ、後述する比較例に比べて輝度を70%以上向上させることができた。

【0061】＜実施例6＞薄膜トランジスタを利用した背面発光型AMタイプの有機電界発光表示装置において、薄膜トランジスタとキャパシタとが形成された第2領域と対応する基板とバッファ層との間に誘電性物質の第1成分のSiOと第2成分のTiとで濃度勾配を有するように外光吸収膜を形成した。

【0062】前述したように製造された有機電界発光表示装置によると、下記表1に示したように反射率を10%未満に減らすことができ、後述した比較例に比べて輝度を200%以上向上させることができた。

【0063】＜比較例1＞透明な基板の上面にITOよりなる第1電極部を形成し、この第1電極部の上面にホール注入層としてフタロシアニン(CuPc)を400で200に蒸着させ、その上部にホール輸送層の役割をするN、N-ジ(ナフタレン-1-イル)-N、N-ジフェニル-ベンジジン(NPB)を300で500の厚さに蒸着させた。そしてホール輸送層の上



部にはトリス - 8 - ヒドロキシキノリンアルミニウム ( $\text{Alq}_3$ ) と LiF 及び Al を各々 400、10、2000 の厚さに蒸着させ、封止材を利用して密封した。

【0064】前述したように製造された有機電界発光表示装置によると、Al 層の反射率が 90% 以上で有機電界発光装置を  $100 \text{ cd/m}^2$  で駆動し、外部光の強度\*

区分	組成(重量%)	輝度	反射光	カソード抵抗	寿命	封止層または電極の構成物質
比較例	偏光板適用	100	10%	100Ω/□以下	100%	
	偏光板未適用	200	100%	100Ω/□以下	100%	
実施例 1		150	10%	100Ω/□以下	150%	SiO-Ti
実施例 2		150	10%	100Ω/□以下	150%	SiO-Ti
実施例 3		150	20%	100Ω/□以下	120%	ITO-Ti
実施例 4		150	10%	100Ω/□以下	200%	$\text{SiO}_x\text{-SiN}_x\text{-Ti}$
実施例 5		170	10%	100Ω/□以下	-	SiO-Ti
実施例 6		200	10%	100Ω/□以下		SiO-Ti

【0067】一方、前述したように外部光を吸収する有機電界発光表示装置の封止層、第 2 電極部または外光吸収膜は次のような工程を通じて製造できる。

【0068】まず、基板の上面に第 1 電極部と有機電界発光部及び第 2 電極部を順次に形成した後、前記基板を真空蒸着器内に蒸着ポートと対向するように固定する段階を行う。そして相異なる融点を有する金属と誘電性物質の混合物、すなわち、前記第 1 成分と第 2 成分のうちいずれか一つが選択されて混合された混合物を一つの蒸着ポートに投入する段階を行う。ここで、金属と誘電性物質の混合物は Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Cu、Pt よりなる群から選択された一つ以上の第 2 成分の金属の 50 ないし 97 重量%と、前記第 1 成分の  $\text{SiO}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{SiN}_x$  ( $x > 1$ )、 $\text{MgF}_2$ 、 $\text{CaF}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SnO}_2$ 、 $\text{In}_2\text{O}_3$  及び ITO よりなる群から選択される一つ以上の誘電性物質の 3 ないし 50 重量%とよりなる。

【0069】次いで、金属と誘電性物質の混合物が入っている蒸着ポートの温度を変化させつつ真空熱蒸着を実施する。この時、蒸着ポートの温度を変化させるためには蒸着ポートに印加される電圧を徐々に高める方法を使用する。

【0070】経時的に蒸着温度を徐々に高めれば誘電性成分の SiO が先に蒸着され、これより高い温度では誘電性成分と金属成分との 2 つの成分が同時に蒸着され、最終的に最も高い温度ではこれ以上の誘電性成分が残らず、純粋に金属成分だけが蒸着される。その結果、図 2 に示されたように SiO は外部光入射方向から離れるほど次第に減少する分布で存在し、金属成分は外部光の入射方向から離れるほど次第に増加する分布で存在する封止層を形成できる。

\*が  $50 \text{ cd/m}^2$  の場合、具現されるコントラストが 2:1 程度で視認性が大きく減少した。

【0065】前述したように実施例と比較例との実験結果を表 1 に示した。

【0066】

【表 1】

【0071】そして前記封止層または電極層の他の形成方法は次の通りである。

【0072】まず、基板の上面に第 1 電極部と有機電界発光部及び第 2 電極部を順次に形成した後、前記基板を真空蒸着器内に蒸着ポートと対向するように固定する段階を行う。相異なる融点を有する誘電性物質よりなるターゲットと、Fe、Co、V、Ti、Al、Ag、Cu、Pt よりなる群から選択された一つ以上の金属よりなるターゲットとを利用してスパッタリングすることによって封止層を形成する。

【0073】

【発明の効果】前記本発明の有機電界発光装置及びこの製造方法は、外部光の反射率を大幅に減らして具現される画像のコントラストと輝度とを向上させ、特に外部光を遮断するための偏光板を除去して生産性の向上を図れる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の一実施形態による有機電界発光表示装置の断面図。

【図 2】図 1 に示された封止層の厚さによる濃度勾配を示すグラフ。

【図 3】封止層の濃度勾配を示す図。

【図 4】封止層の濃度勾配を示す図。

【図 5】本発明の他の実施形態による有機電界発光表示装置を示す断面図。

【図 6】本発明の他の実施形態による有機電界発光表示装置を示す断面図。

【図 7】図 5 に示された第 2 電極部の濃度勾配を示すグラフ。

【図 8】本発明の他の実施例を示す有機電界発光表示装置の断面図。

【図9】本発明の他の実施例を示す有機電界発光表示装置の断面図。

【図10】図9に示された有機電界発光表示装置の配列を示す図。

【図11】本発明による有機電界発光表示装置の他の実施形態を示す断面図。

【図12】本発明による有機電界発光表示装置の他の実施形態を示す断面図。

【図13】本発明による有機電界発光表示装置の他の実施形態を示す断面図。

【図14】本発明による有機電界発光表示装置の他の実\*

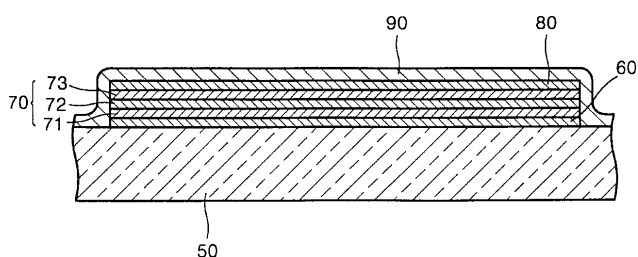
\*施形態を示す断面図。

【図15】従来の有機電界発光表示装置の断面図。

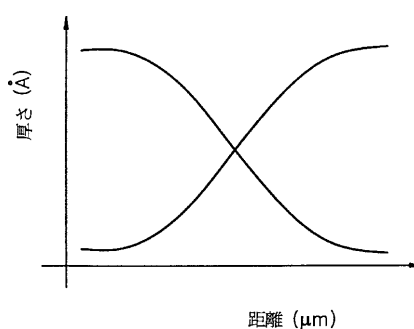
【符号の説明】

- 50 基板
- 60 第1電極部
- 70 有機電界発光部
- 71 ホール輸送層
- 72 発光層
- 73 電子輸送層
- 80 第2電極部
- 90 封止層

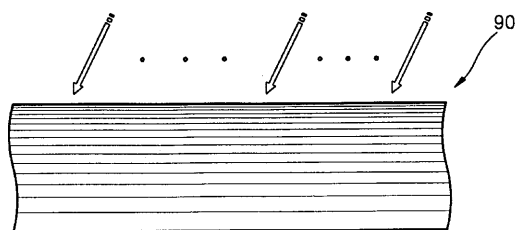
【図1】



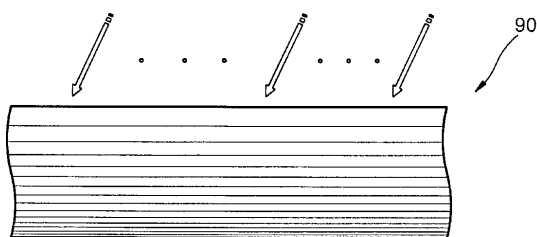
【図2】



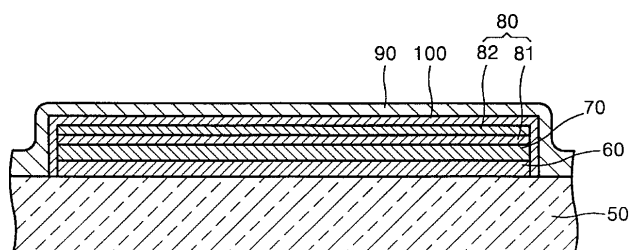
【図3】



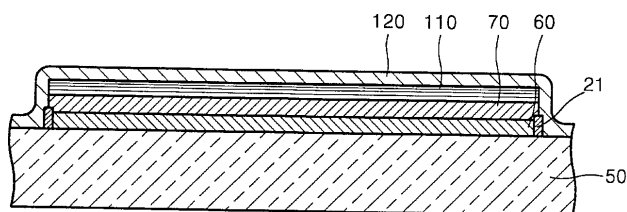
【図4】



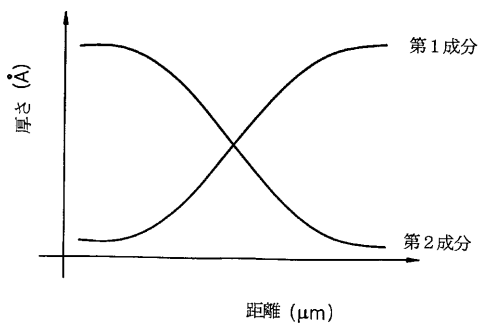
【図5】



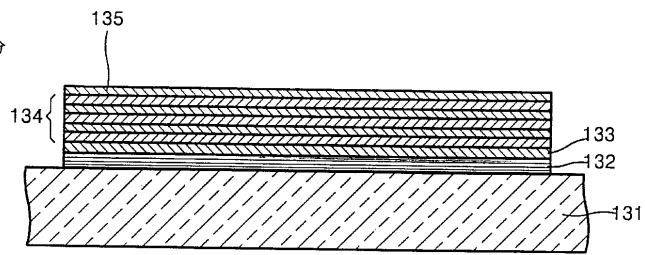
【図6】



【図7】

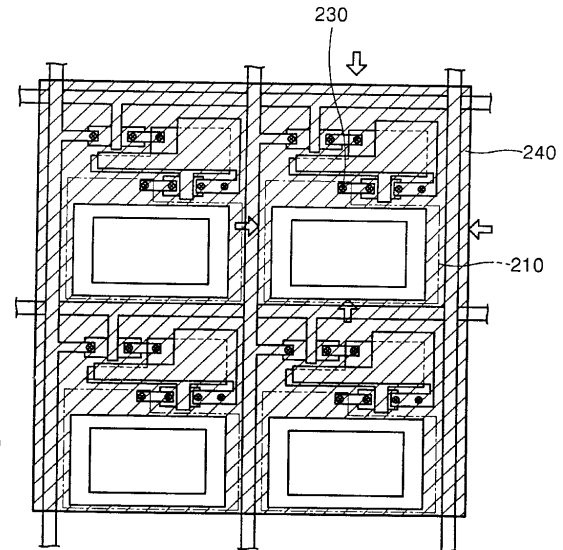
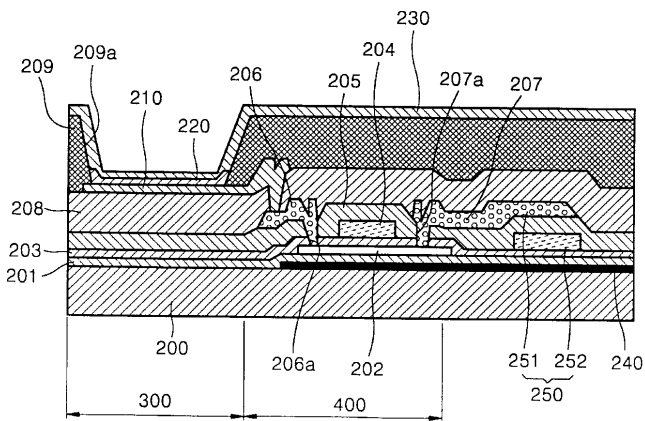


【図8】

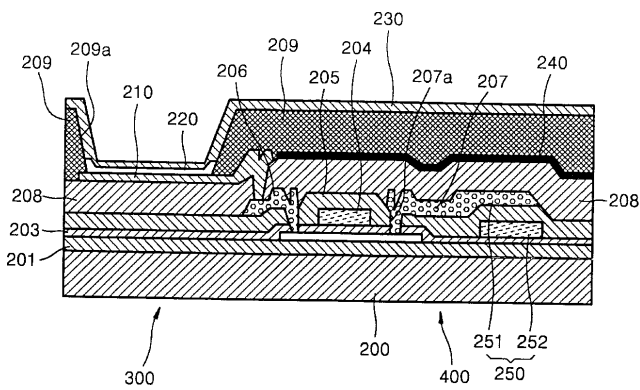


【図10】

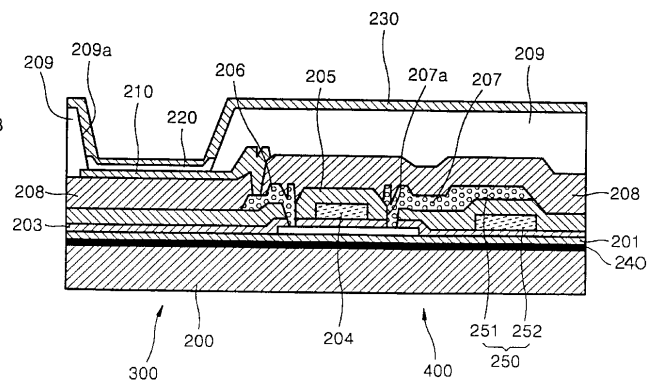
【図9】



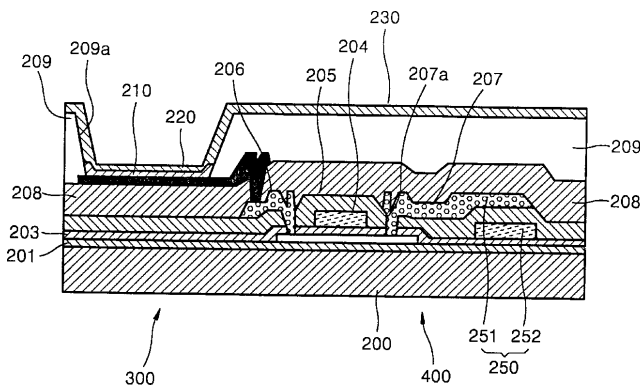
【図11】



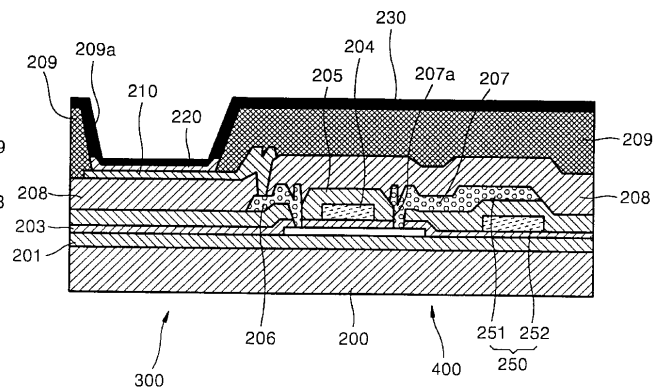
【図12】



【図13】

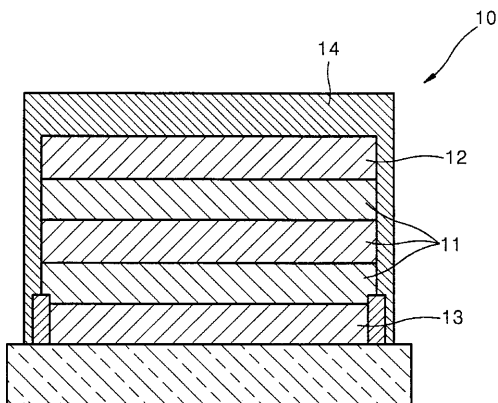


【図14】



【図15】

(従来の技術)



フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>

H 0 5 B 33/28

識別記号

F I

H 0 5 B 33/28

テ-マ-コード (参考)

(72)発明者 朴 昌元

大韓民国京畿道水原市靈通洞1047 - 1 番地  
 清明マウル4 団地建栄アパート421棟902  
 号

(72)発明者 朴 鎮宇

大韓民国京畿道水原市長安区栗園洞881番  
 地 韓一タウンアパート127棟406号

(72)発明者 申 東纘

大韓民国京畿道華城市台安邑半月里860番  
 地 現代アパート302棟304号

F タ-ム (参考) 3K007 AB02 AB17 AB18 BB00 BB06

BB07 CB01 CC00 DB03 FA02

专利名称(译)	有机发光显示器		
公开(公告)号	<a href="#">JP2003197368A</a>	公开(公告)日	2003-07-11
申请号	JP2002217117	申请日	2002-07-25
[标]申请(专利权)人(译)	三星斯笛爱股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	三星エスディアイ株式会社		
[标]发明人	李準培 朴昌元 朴鎮宇 申東纘		
发明人	李 準培 朴 昌元 朴 鎮宇 申 東纘		
IPC分类号	H05B33/04 H01L27/32 H01L51/50 H01L51/52 H05B33/10 H05B33/22 H05B33/26 H05B33/28 H05B33/14		
CPC分类号	H01L51/5284 H01L27/3272 H01L51/5206 H01L51/5221 H01L51/5253 H01L2251/5315 H01L2251/5346		
FI分类号	H05B33/04 H05B33/10 H05B33/14.A H05B33/22.Z H05B33/26.Z H05B33/28		
F-TERM分类号	3K007/AB02 3K007/AB17 3K007/AB18 3K007/BB00 3K007/BB06 3K007/BB07 3K007/CB01 3K007/CC00 3K007/DB03 3K007/FA02 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC02 3K107/CC32 3K107/DD02 3K107/DD22 3K107/DD27 3K107/DD29 3K107/DD44Y 3K107/DD46Y 3K107/DD89 3K107/EE03 3K107/EE27 3K107/EE48 3K107/EE50 3K107/FF04 3K107/FF06 3K107/FF14 3K107/GG04		
优先权	1020010085101 2001-12-26 KR		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

# 摘要(译)

有机发光显示器通过显著降低外部光的反射率显著提高了图像的对比度和亮度，并且特别是通过去除用于阻挡外部光的偏振片来提高了生产率。提供设备。透明基板（50），以预定图案形成在基板（50）的上表面上并由透明导电材料制成的第一电极部分（60），以及在第一电极部分（60）上具有预定图案的有机膜。堆叠的有机电致发光部分70，第二电极部分80以预定的图案形成在有机电致发光部分70的上表面上，以对应于第一电极部分60，第一电极部分，电场 形成为覆盖并保护发光部和第二电极部以及选自第一成分和Fe，Co，V，Ti，Al，Ag和Pt组成的组中的至少一个第二成分。有机电致发光显示装置由包含其的密封层90构成。

